

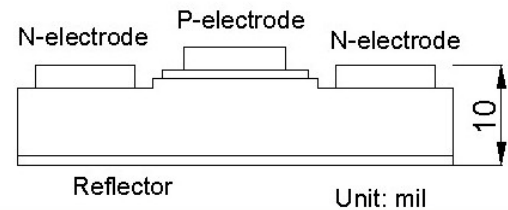
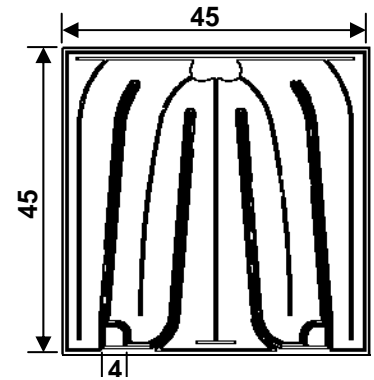


◆ 产品特点:

- 高亮度、长寿命
- 户内外应用
- 芯片百分百测试分选
- 波长和光强良好一致性

◆ 物理参数:

P 电极	金
N 电极	金
芯片尺寸	45mil × 45mil (1140±25µm×1140±25µm)
芯片厚度	10mil (250 ± 25µm)
焊盘尺寸	4mil (100 ± 25µm) in diameter



◆ 光电参数: (Tc=22°C, I_F=350mA)

产品型号	波长范围 (λ _D , nm)		工作电压 (V _F , V)	反向漏电流 (I _R , µA) @V _R =5V	半波宽度 (Δλ, nm)	最大电流 (I _F , mA) DC
	Min	Max				
S-45BBMUP*-445E**	445	450	≤3.6	≤2	≤35	700
S-45BBMUP*-450E**	450	455				
S-45BBMUP*-455E**	455	460				
S-45BBMUP*-460E**	460	465				
S-45BBMUP*-465E**	465	470				

◆ 光强等级: (Tc=22°C, I_F=350mA)

等级	...	W03	W04	W05	W06	W07	...
Power (mW)	...	260-290	290-320	320-350	350~380	380-410	...

◆ 其它说明:

- 光电参数均系三安光电测试仪器在晶圆条件下的测试参数, 98%符合标称值范围
- 芯片封装工艺最高温度低于 280°C, 持续时间小于 10 秒
- GaN LED 芯片为静电敏感产品, 使用、运输时注意静电防护
- 主波长测量误差±1.0nm
- 可根据客户要求订做特殊规格的芯片